

ПРОГРАММА
3-ой школы молодых ученых
«Актуальные проблемы полупроводниковых
наносистем»

7–9 декабря 2021 г.

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13

Вторник, 7 декабря			
9:00 – 9:15	Открытие		
9:15 – 10:00	Латышев Александр Васильевич	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Физико-химические основы создания функциональных полупроводниковых наносистем РФФ 19-72-30023
10:00 – 10:45	Чувилин Андрей Леонидович	SIC NanoGUNE BRTA, Spain	Количественные методы измерений в электронной микроскопии
10:45 – 11:30	Саранин Александр Александрович	ИАПУ ДВО РАН, г.Владивосток	Двумерные металлы атомной толщины : синтез и свойства
11:30 – 11:45	Перерыв, кофе-брейк		
11:45 – 12:30	Двуреченский Анатолий Васильевич	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Управление функциональными характеристиками компонент наноэлектроники и нанофотоники на основе гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками
12:30 – 13:15	Попов Владимир Павлович	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Многослойные наноструктуры полупроводник-диэлектрик как основа для нейроморфных, радиофотонных и квантовых микросхем
13:15 – 14:00	Обед		

14:00 – 14:45	Терещенко Олег Евгеньевич	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Исследование электронной и спиновой структуры наносистем методом фотоэмиссии с угловым и спиновым разрешением
14:45 – 15:30	Кох Константин Александрович	ИГМ СО РАН, г.Новосибирск	Оптимизация метода Бриджмена для выращивания монокристаллов слоистых халькогенидов
15:40 – 18:40	Чувилин Андрей Леонидович	CIC NanoGUNE BRTA, Spain	Визуализация и количественные измерения полей деформаций в полупроводниковых гетероструктурах при ВРЭМ исследованиях

Среда, 8 декабря			
09:00 – 10:45	Представление стендов участниками Школы		
10:45-11:00	Перерыв, кофе-брейк		
11:00 – 14:00	Стендовая сессия		
14:00 – 15:00	Обед		
15:00 – 15:45	Гутаковский Антон Константинович	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Атомная структура нанокристаллов силицидов железа и хрома в матрице кремния
15:45 – 16:30	Авилов Анатолий Сергеевич	ИК РАН, г.Москва	Структурные процессы в наносистемах по данным электронной кристаллографии
16:30 – 17:15	Васильев Александр Леонидович	НИЦ Курчатовский институт, г.Москва	Двойникование в нано- и микрокристаллах

17:15 – 18:00	Косолюбов Сергей Сергеевич	Сколковский институт науки и технологий, г.Москва	Диффузия и атомные реакции на поверхности, границах раздела и в объеме кристалла
---------------	----------------------------	---	--

Четверг, 9 декабря			
9:00 – 9:45	Шварц Наталья Львовна	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Монте-Карло моделирование процессов формирования полупроводниковых наноструктур
9:45 – 10:30	Жачук Руслан Анатольевич	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Исследование структуры и свойств поверхностей полупроводников с помощью расчетов на основе теории функционала плотности
10:30 – 11:15	Ковалев Вадим Михайлович	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Экситоны как искусственные атомы: фундаментальные свойства и приборные приложения.
11:15-11:30	Перерыв, кофе-брейк		
11:30 – 12:15	Ткаченко Виталий Анатольевич	ИФП СО РАН, г.Новосибирск	Структурно-геометрическое и полевое управление сопротивлением квантовых наносистем: опыты и модели
12:15 – 13:00			
13:00 – 14:20	Обед		
14:20 – 17:20	Практические демонстрационные занятия по атомно силовой микроскопии. Возможности сканирующей электронной микроскопии для диагностики различных наносистем.		

17:20-18:00	Закрытие школы
-------------	-----------------------

Пятница, 10 декабря	Практические занятия в лаборатории по методам структурного анализа
------------------------	---